



济南市半导体元件实验所

# ESD 保护 TVS 二极管阵列系列产品

## ZL3Q15S6P 型 ESD 保护 TVS 二极管阵列

### 1 特性

- 低电容；
- 静电敏感等级：非敏感；
- 双向；
- 封装外形：SOT-363。

### 2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611，Q/RBJ 60064-2021。

### 3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

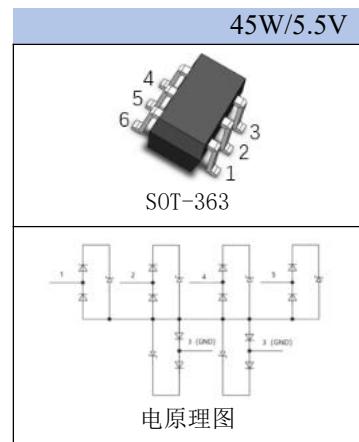
型号	工作电压 $V_{\text{RW}}$ V	脉冲电流 $I_{\text{pp}}$ ( $t_p=8/20 \mu\text{s}$ ) A	脉冲功率 $P_{\text{pp}}$ ( $t_p=8/20 \mu\text{s}$ ) W	静电防护电压 (接触) kV	静电防护电压 (空气) kV	工作温度 $T_A$ °C	储存温度 $T_{\text{stg}}$ °C
ZL03Q15S6P	5.5	3	45	±12	±15	-55~125	-55~150

### 4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}\pm3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

参数名称	符号	条 件 除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$	数 值			单 位
			最 小 值	典 型 值	最 大 值	
箝位电压	$V_{C1}$	$I_{\text{pp}}=1\text{A}$ , $t_p=8/20 \mu\text{s}$ , 通道到地或地到通道	-	10.9	15	V
	$V_{C2}$	$I_{\text{pp}}=3\text{A}$ , $t_p=8/20 \mu\text{s}$ , 通道到地或地到通道	-	-	17	V
击穿电压	$V_{BR}$	$I_i=1\text{mA}$ , 通道到地或地到通道	7.8	-	9.5	V
反向电流	$I_{R1}$	$V_R=2.5\text{V}$ , 通道到地或地到通道	-	-	100	nA
反向电流	$I_{R2}$	$V_R=2.5\text{V}$ , 通道到地或地到通道, $T_A=125^\circ\text{C}$	-	-	100	$\mu\text{A}$
对地电容	$C_{1/0}$	$V_R=2.5\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ , 1、2、4、5脚分别对3脚	-	-	0.95	pF





## 5 外观尺寸

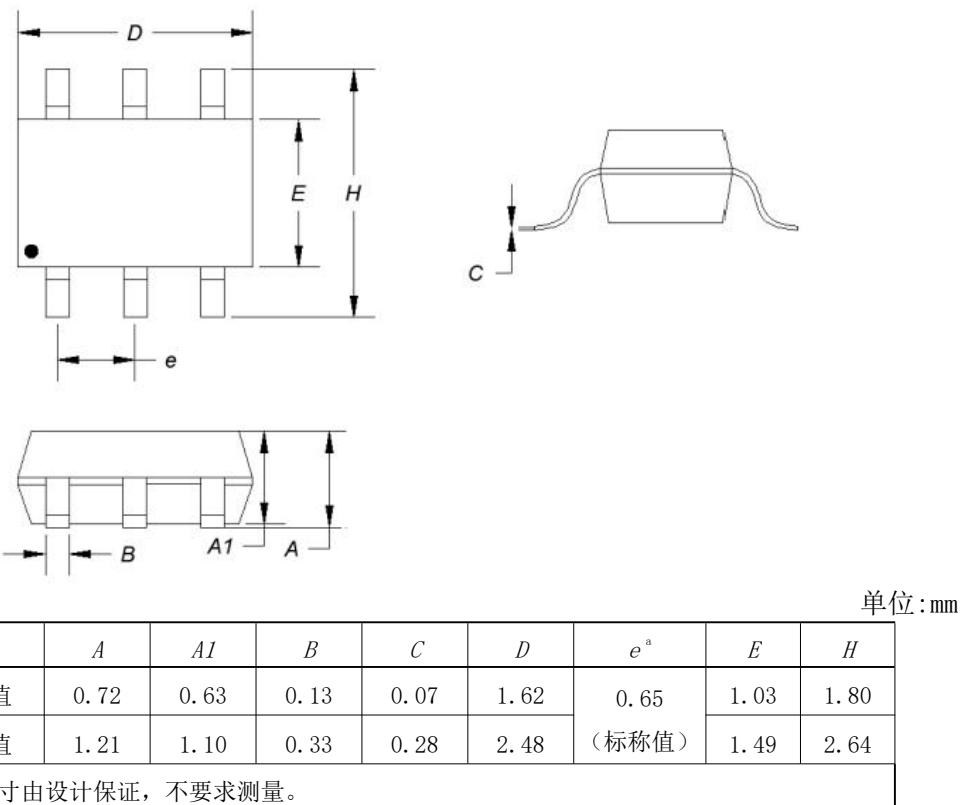


图 1 SC70-6 外形尺寸

## 6 原理图

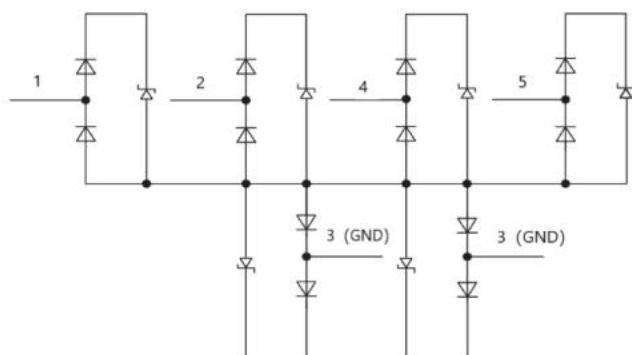


图 2 原理图